

**財團法人潘文淵文教基金會**  
**胡正明半導體創新獎 獎勵辦法**

民國一十二年十月二十日 本會第十屆第二次董事會訂定

一、目的

財團法人潘文淵基金會（以下簡稱本會）為獎勵國內半導體相關領域，具備國際級水準卓越表現之優秀人士，特訂定本辦法；本獎項為胡正明院士獲得之「總統科學獎」獎金 200 萬元捐贈給潘文淵文教基金會做為獎金來源，特命名為「胡正明半導體創新獎」。

二、獎勵名額及評審條件

每年辦理一次，「半導體元件、材料與製程創新獎」及「半導體產品設計與應用創新獎」各一名，共計二名。得獎者需具有國際水準，由評審委員從寬解讀，以國內最佳創新為基本條件。如果評審委員認為國內最佳申請人並未參與申請，得請評審委員以個人名義鼓勵最佳申請人於下一年度提出申請。

三、申請資格

- （一）國內從事研究工作有卓越成績之 55 歲以下研究人員。
- （二）已得本會任何獎項者，本創新獎不再為同一件創新受理申請。
- （三）申請人得同時申請「半導體元件、材料與製程創新獎」與「半導體產品設計與應用創新獎」。

四、申請程序

- （一）由下列機構或個人推薦有關政府機關、學校有關企業團體或企業有關學術研究機構或團體有關人士。
- （二）推薦人應提供資料，格式如附件，於申請期限內寄/傳達本會。

五、評審作業

（一）評審程序

初審：由本會工作小組進行資格審查。

複審：由本會聘請相關領域之技術專家進行書面審查。

決審：由評審委員會就複審時之專家意見進行審議，並決定得獎名單。

（二）評審委員會

由本會聘請學者、專家五至七人擔任委員，任期三年，並推舉一人擔任召集人。

#### 六、頒獎表揚

- (一) 頒發獎章及新台幣 10 萬元獎金，並於每年四月舉行之 VLSI TSA 國際研討會中公開表揚。
- (二) 得獎人應親自出席，若不克領獎，則本基金會保留其獎金做為與本會相關活動之權利。

七、本辦法經本會之董事會通過後實施，修正時亦同。